

1. (a) 導体の表面に電子は分布するが、導体内は等電位になるので表面に様に分布する。この対称性から電場も球対称になる。よって導体球の作る電場は、球の中心からの距離 r にのみ依存する。

導体内では電場 $E(r)$ は存在しないので、

$r \geq a$ のとき、ガウスの法則より、

$$\int_{S_0} E(r) ds = 4\pi r^2 E(r) = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

よって

$$E(r) = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (r \geq a) \\ 0 & (r < a) \end{cases}$$

- (b) 導体球殻においても、電荷 $-Q$ は一様に分布する。

- (c) 導体球殻の外側の電場は、中心に点電荷があるときと同じであるが、点電荷は $Q + (-Q) = 0$ であるので、外側に電場は存在しない。
また導体球殻は内側に電場を作らないので

$$E(r) = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (a \leq r \leq b) \\ 0 & (r < a, b < r) \end{cases}$$

- (d) 基準点は無限遠なので、 $r > b$ では電場が存在しないことから

$$\phi(r) = 0$$

$a \leq r \leq b$ のとき

$$\begin{aligned} \phi(r) &= -\int_{\infty}^r E(r) dr = -\int_b^r E(r) dr - \int_{\infty}^b E(r) dr \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{b} \right) \end{aligned}$$

導体内では電位が一定なので

$$\phi(r) = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) & (r < a) \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{b} \right) & (a \leq r \leq b) \\ 0 & (r > b) \end{cases}$$

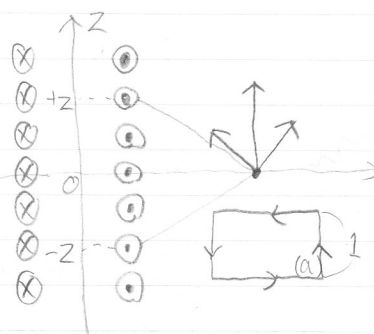
~~~~~ 省略 ~~~~~

$$(e) U = \frac{1}{2} Q V \text{ より } U = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

$$(f) C = \frac{Q}{V} \text{ より } C = \frac{4\pi\epsilon_0}{\left( \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)}$$

(g) 分母を小さくすれば電気容量は大きくなるので  
導体球殻の半径を  $a$  に近づける。

2. (a) 右図の様に  $z$  軸を定め、 $z=0$  の面での  
磁場を考えても一般性を失わない (端の  
効果を見捨てるから)  
 $z$  の位置のコイルが作る磁場のベクトル  
を合成すると、 $z$  方向以外の磁場がなくな  
ることになる。



右図のような閉曲線 (a) を考えると、 $z$  軸に  
垂直な成分に対しては  $\oint d\mathbf{c} \cdot \mathbf{B} = 0$  なので

$$\oint d\mathbf{c} \cdot \mathbf{B} = (B_z^{(左)} - B_z^{(右)}) = 0 \text{ より } B_z^{(左)} = B_z^{(右)}$$

閉曲線を平行移動しても同じ結果がえられ、

ビオ・サバール法の法則より無限遠での磁場は 0 なので  
コイルの外部では磁場はゼロになる。

(b) 右上図における  $-z$  方向

(c) コイルの間に閉曲面を考えると、(a) と同様にして  
内部の位置に依存しないことになる。

(d) コイルをまたぐように閉曲線を考えると、外部での磁場はゼロなので

$$\oint d\mathbf{c} \cdot \mathbf{B} = l B_z = \mu_0 n I$$

$$\text{よって } B_z = \mu_0 n I$$

$$(e) \ln \Phi = \ln \int_S B_z dS = LI \text{ より}$$

$$\ln \int_S B_z dS = \pi a^2 \mu_0 \ln I = LI$$

よって自己インダクタンス  $L$  は

$$L = \pi a^2 \mu_0 \ln^2$$

$$(f) \phi = -\frac{d\Phi}{dt} = -L \frac{dI}{dt} \text{ より}$$

$$I = -\frac{1}{L} \int V_0 \cos \omega t dt$$

$$= -\frac{V_0}{L\omega} \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

よって電流の大きさは自己インダクタンスと角速度に反比例し、  
電流の位相は電圧より  $\frac{\pi}{2}$  遅れる。

3.(a) (1) 電場は電荷があるところでは影響を受けない。

(2) 磁場の時間変化があれば電場は生じる。

(3) 磁力線は閉曲線ではない。磁場には源がない。

(4) 電場の時間変化と電流により磁場が生じる。

(b) (2) コイルに磁石を近づけると電流が流れる。

$$4.(a) E(x) = -\text{grad } \phi(x)$$

(b) 導体は外部の電場を遮蔽する。導体内部は外部の電場の影響を受けない。

$$(c) \Delta B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\Delta S \times r}{r^3} = \frac{\mu_0 I \Delta S \sin \theta}{4\pi r^2}$$

(d) 2つの平行な電流が存在するとき、それらの間に生じる力。